Preliminary datasheet

EasyDUAL 模块 采用 CoolSiC™ Trench MOSFET 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC

特性

Typical appearance

- 电气特性
  - V_{DSS} = 1200 V
  - I_{DN} = 100 A / I_{DRM} = 200 A
  - 低电感设计
  - 低开关损耗
- 机械特性
  - PressFIT 压接技术
  - 集成 NTC 温度传感器
  - 集成的安装夹使安装坚固
  - 低热阻的氮化铝 (AlN)衬底

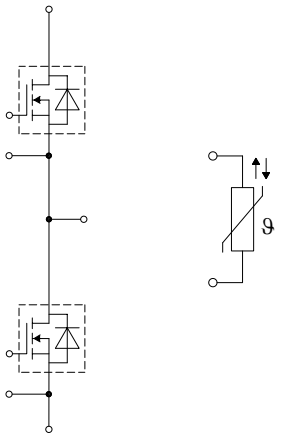
可选应用

- 高频开关应用
- DC/DC 变换器
- UPS 系统
- 电动车直流充电

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

	描述	1
	特性	1
	可选应用	1
	产品认证	1
	内容	2
1	封装	3
2	**MOSFET**	3
3	**Body diode (MOSFET)**	5
4	负温度系数热敏电阻	6
5	特征参数图表	7
6	电路拓扑图	12
7	封装尺寸	13
8	模块标签代码	14
	修订历史	15
	免责声明	16

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.0	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	AlN	
相对电痕指数	*CTI*		> 200	
相对温度指数 (电)	*RTI*	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{sCE}			9		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, 每个开关		2		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	*F*		20		50	N
重量	*G*			24		g

注: *The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.*

2 MOSFET

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
漏源极电压	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
连续漏极直流电流	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 105 °C	100	A
漏极重复峰值电流	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		200	A
栅-源瞬态最大电压	V_{GS}	*D* < 0.01		-10/23	V
栅-源稳态最大电压	V_{GS}			-7/20	V

表 4 推荐值

特征参数	代号	标注或测试条件	[ZH]Values	单位
通态栅极电压	$V_{GS(on)}$		15...18	V
断态栅极电压	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

表 5 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源通态电阻	$R_{DS(on)}$	I_D = 100 A	V_{GS} = 18 V, T_{vj}=25 °C		8.1		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj}=125 °C		13.1		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj}=150 °C		15.1		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		9.7		
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	I_D = 40 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.45	4.3	5.15	V
栅极电荷	Q_G	V_{DD}=800 V, V_{GS} = -3/18 V			0.297		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj}=25 °C			2.1		Ω
输入电容	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		8.8		nF
输出电容	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		0.42		nF
反向传输电容	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS}=800 V, V_{GS}=0 V	T_{vj}=25 °C		0.028		nF
C_{OSS} 存储能量	E_{OSS}	V_{DS}=800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			172		µJ
漏源泄漏电流	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.06	380	µA
栅极漏电流	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS}=20 V			400	nA
开通延迟时间(感性负载)	$t_{d\,on}$	I_D = 100 A, R_{Gon} = 8.2 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		53		ns
			T_{vj} = 125 °C		53		
			T_{vj} = 150 °C		53		
上升时间(感性负载)	t_r	I_D = 100 A, R_{Gon} = 8.2 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		70		ns
			T_{vj} = 125 °C		70		
			T_{vj} = 150 °C		70		
关断延迟时间(感性负载)	$t_{d\,off}$	I_D = 100 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		73		ns
			T_{vj} = 125 °C		79		
			T_{vj} = 150 °C		81		
下降时间(感性负载)	t_f	I_D = 100 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 600 V, V_{GS} = -3/18 V	T_{vj} = 25 °C		20		ns
			T_{vj} = 125 °C		20		
			T_{vj} = 150 °C		20		

(待续)

表 5 **(续) 特征值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_D = 100 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 8.2 Ω, di/dt = 3.88 kA/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.87		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.05		
			T_{vj} = 150 °C		3.12		
关断损耗能量 (每脉冲)	E_{off}	I_D = 100 A, V_{DD} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 2.7 Ω, dv/dt = 24 kV/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.75		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.81		
			T_{vj} = 150 °C		0.82		
短路数据	I_{SC}	V_{GS} = -5/15 V, V_{DD} = 800 V, V_{DSmax} = V_{DSS}-L_{sDS}*di/dt, R_G = 10 Ω	t_P = 2 µs, T_{vj} = 25 °C		840		A
			t_P = 2 µs, T_{vj} = 150 °C		820		
结一散热器热阻	R_{thJH}	每个 MOSFET, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.311		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

注: *The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.*

3 Body diode (MOSFET)

表 6 **最大标定值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
体二极管正向直流电流	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 105 °C	55	A

表 7 **特征值**

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_{SD}	I_{SD} = 100 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.2	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		3.9		
			T_{vj} = 150 °C		3.85		

4 负温度系数热敏电阻

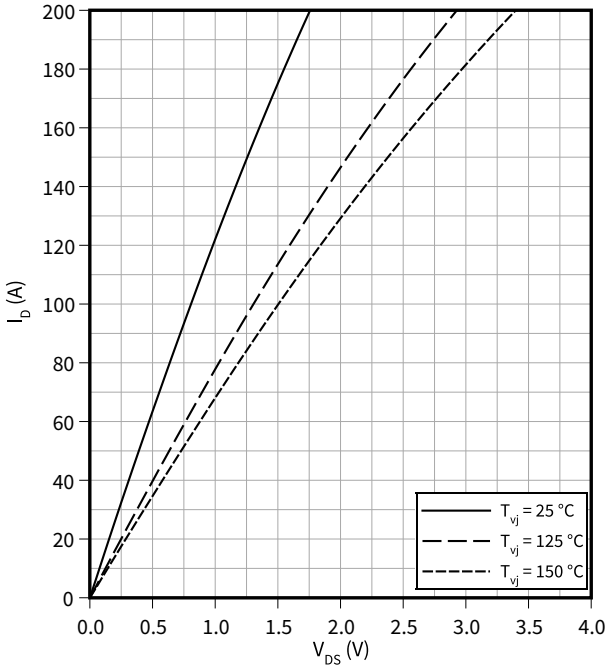
表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

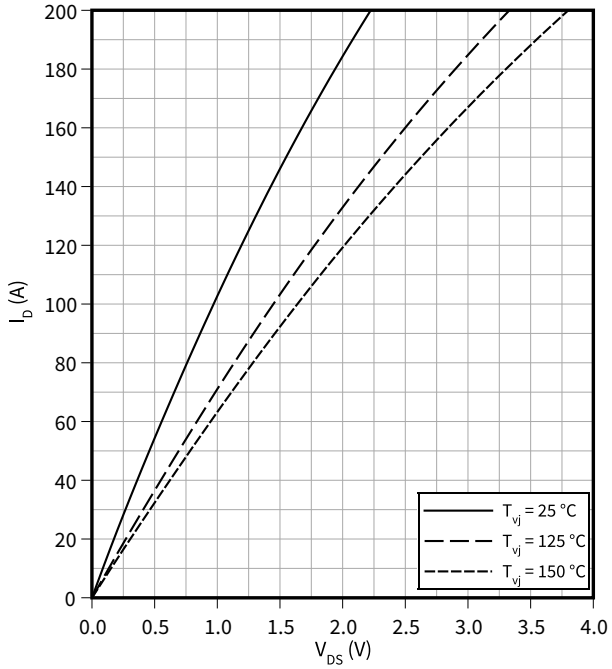
注: 根据应用手册标定

5 特征参数图表

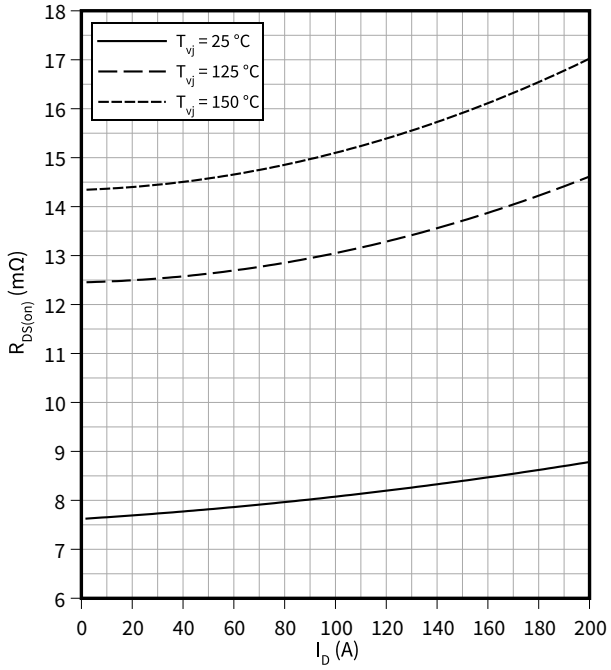
输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 18$ V



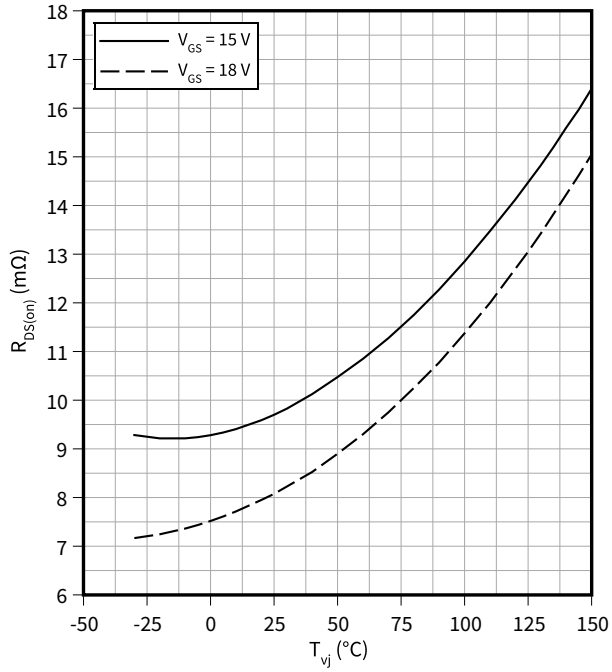
输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 15$ V



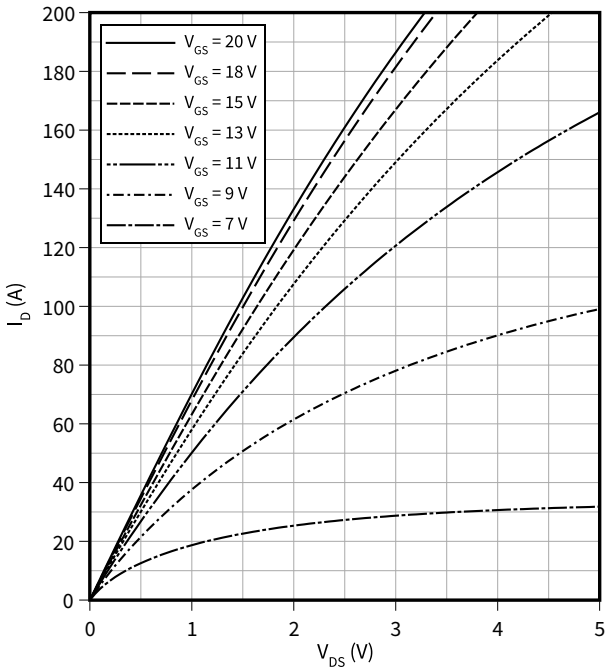
漏源通态电阻 （典型), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(I_D)$
$V_{GS} = 18$ V



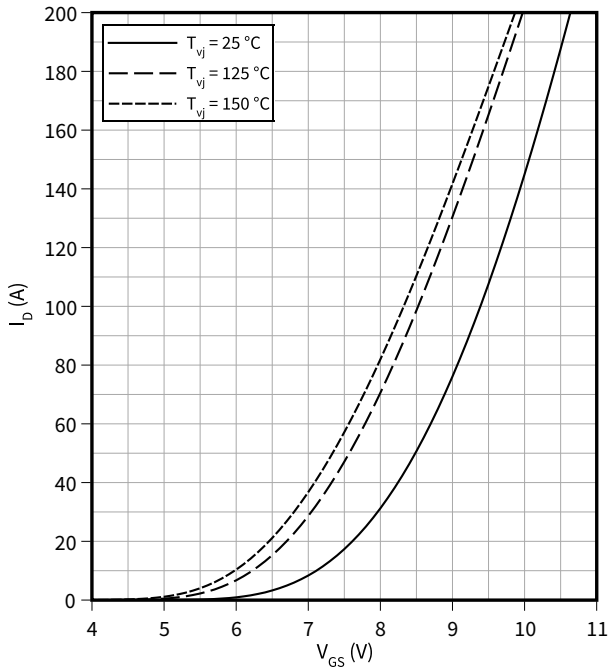
漏源通态电阻 （典型), MOSFET
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
$I_D = 100$ A



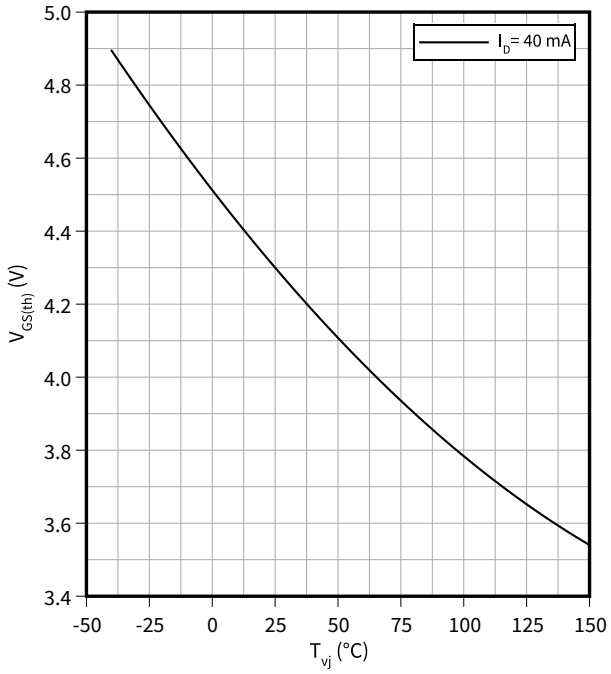
输出特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{DS})$
$T_{vj} = 150\ °C$



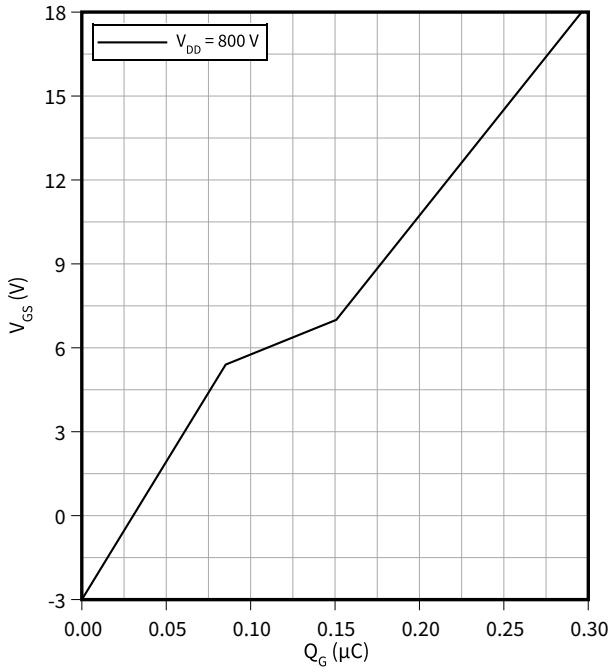
传输特性 （典型), MOSFET
$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20\ V$



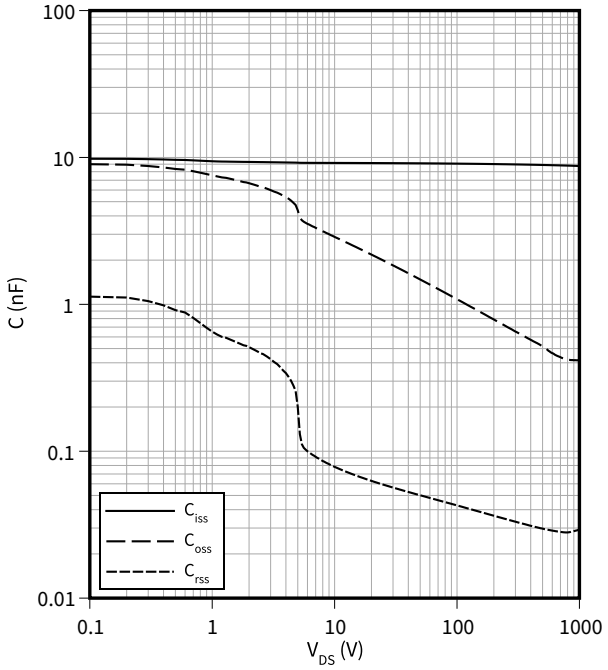
栅-源阀值电压（典型）, MOSFET
$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$



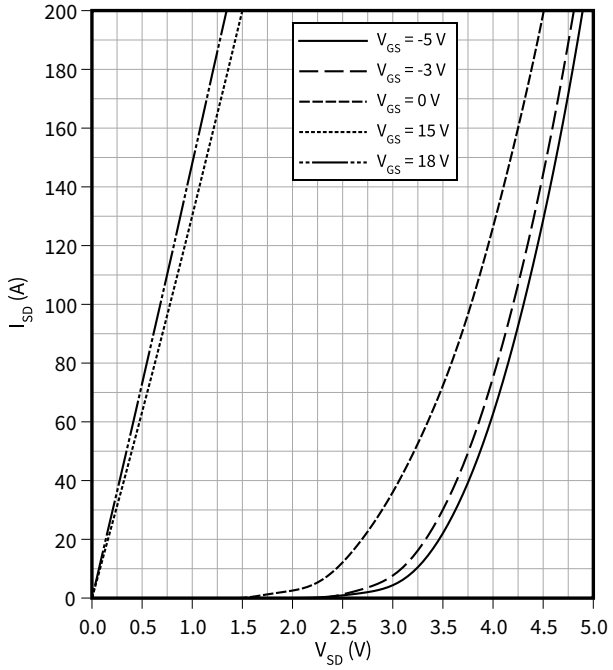
栅极电荷特性 （典型), MOSFET
$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 100\ A,\ T_{vj} = 25\ °C$



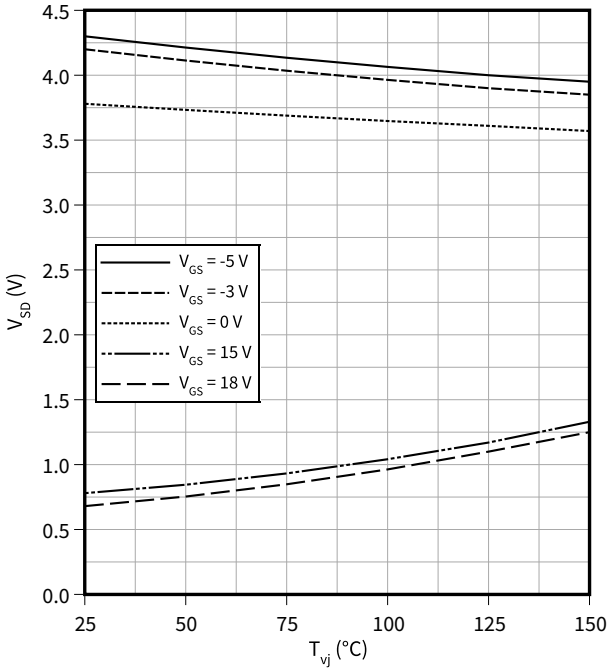
电容特性 （典型), MOSFET
$C = f(V_{DS})$
$f = 100\ kHz$, $T_{vj} = 25\ °C$, $V_{GS} = 0\ V$



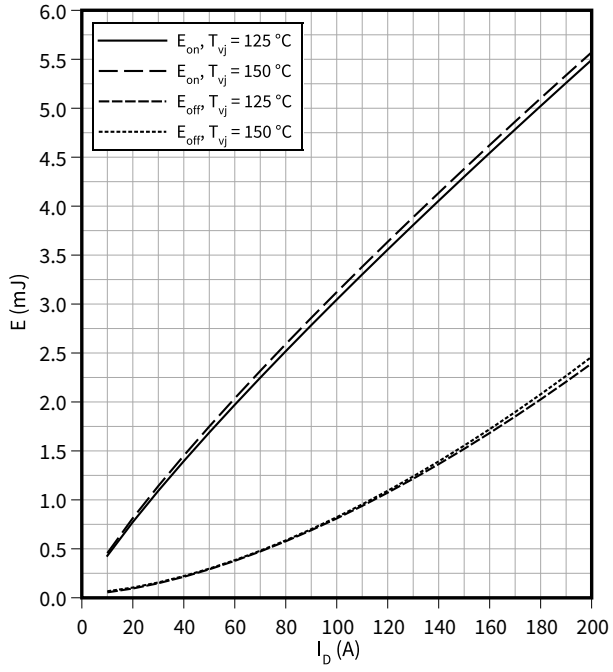
正向特性 体二极管（典型), MOSFET
$I_{SD} = f(V_{SD})$
$T_{vj} = 25\ °C$



体二极管正向压降（典型), MOSFET
$V_{SD} = f(T_{vj})$
$I_{SD} = 100\ A$



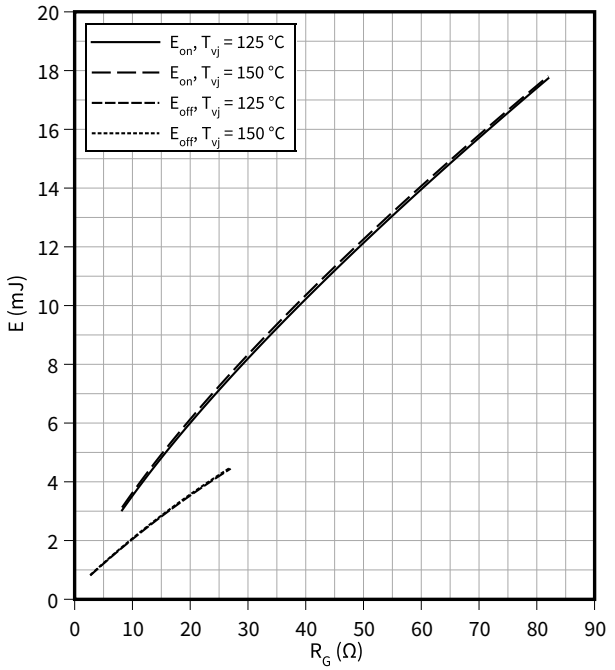
开关损耗 （典型), MOSFET
$E = f(I_D)$
$R_{Goff} = 2.7\ \Omega$, $R_{Gon} = 8.2\ \Omega$, $V_{DD} = 600\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



开关损耗 （典型), MOSFET

$E = f(R_G)$

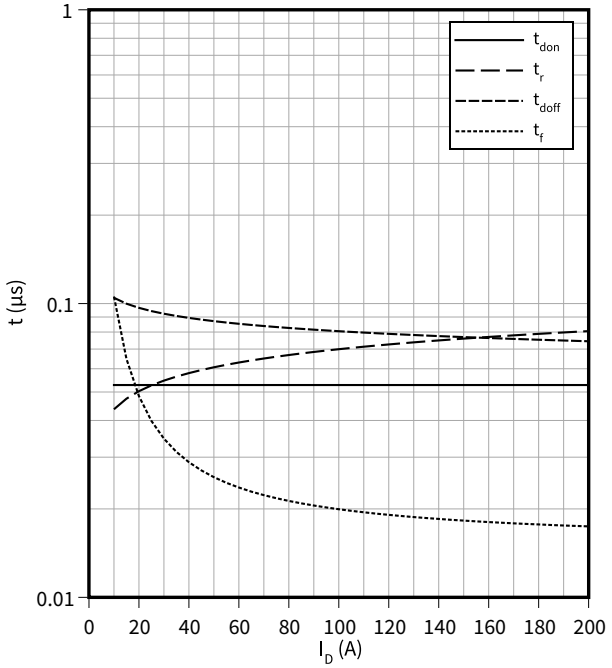
V_{DD} = 600 V, I_D = 100 A, V_{GS} = -3/18 V



开关时间 （典型), MOSFET

$t = f(I_D)$

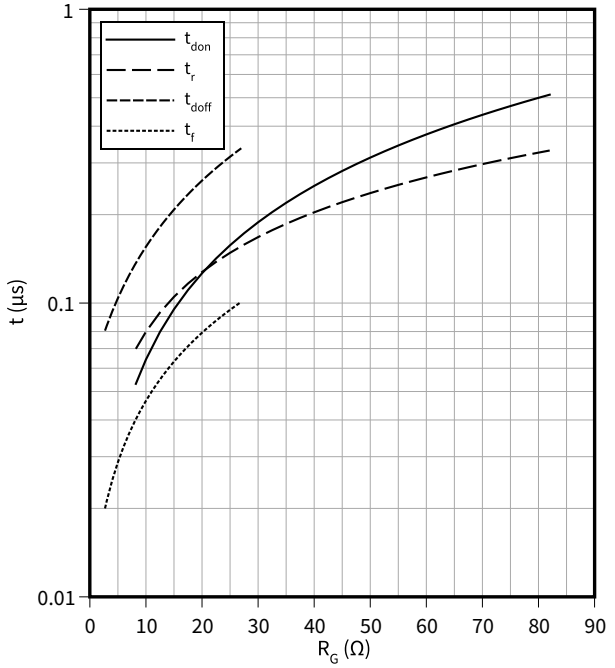
R_{Goff} = 2.7 Ω, R_{Gon} = 8.2 Ω, V_{DD} = 600 V, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V



开关时间 （典型), MOSFET

$t = f(R_G)$

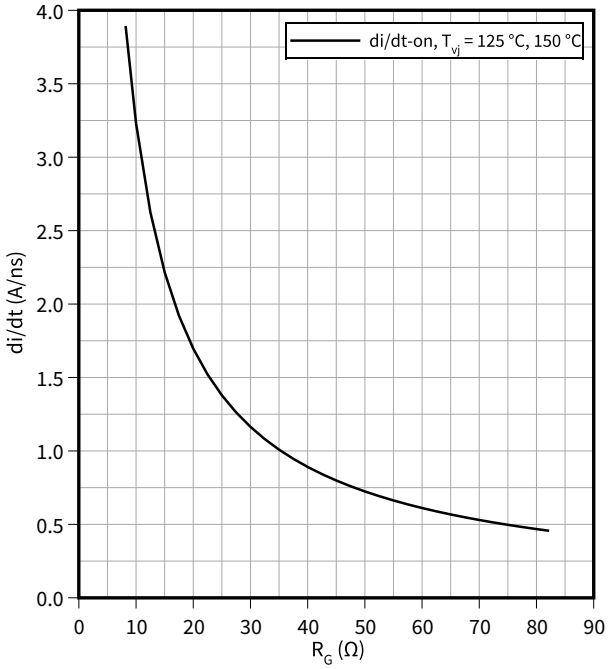
V_{DD} = 600 V, I_D = 100 A, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V



电流变化斜率 （典型), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$

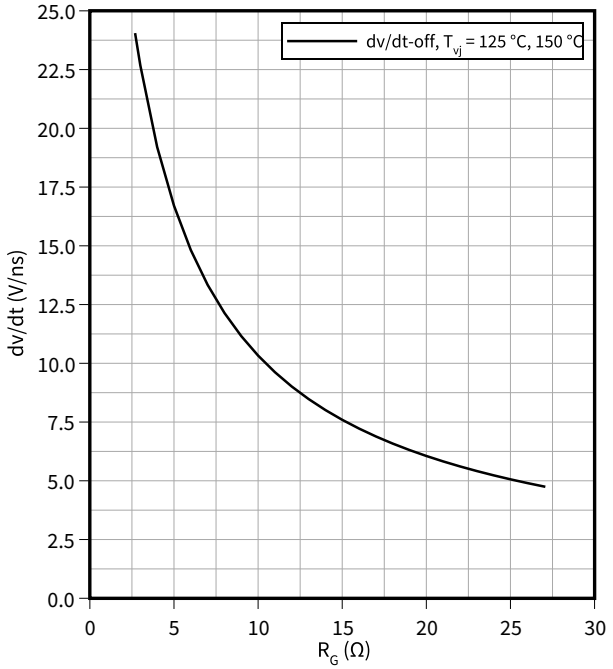
V_{DD} = 600 V, I_D = 100 A, V_{GS} = -3/18 V



电压变化斜率 （典型), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

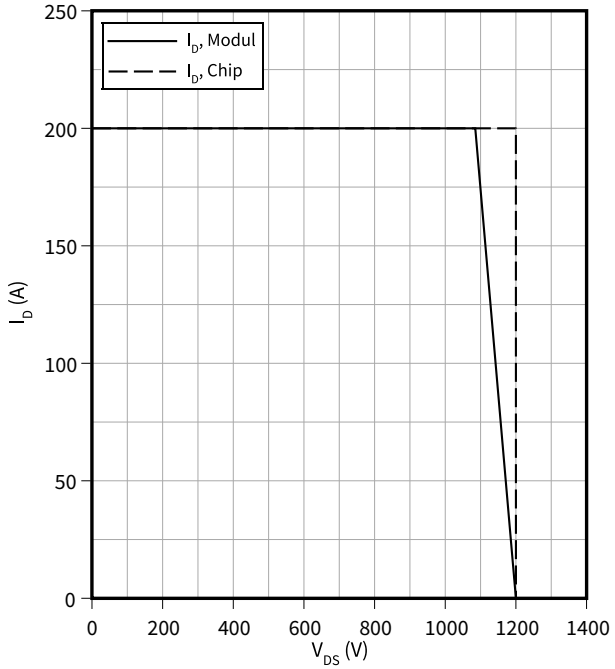
V_{DD} = 600 V, I_D = 100 A, V_{GS} = -3/18 V



反偏安全工作区 （RBSOA）, MOSFET

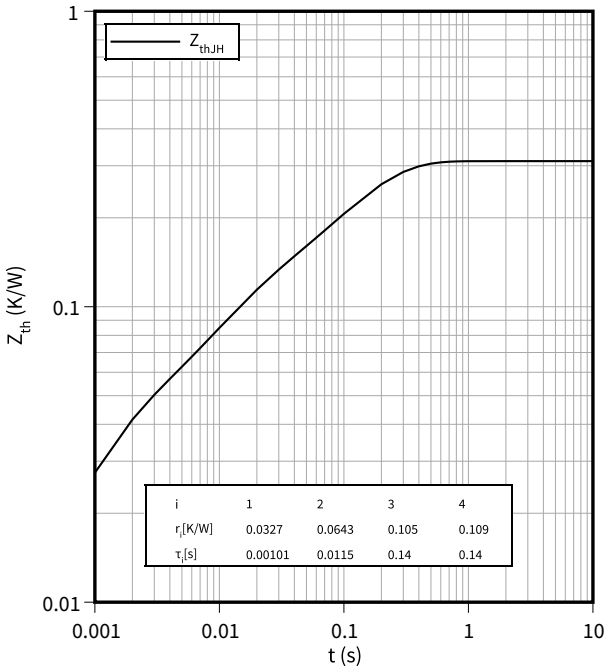
$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 2.7 Ω, T_{vj} = 150 °C, V_{GS} = -3/18 V



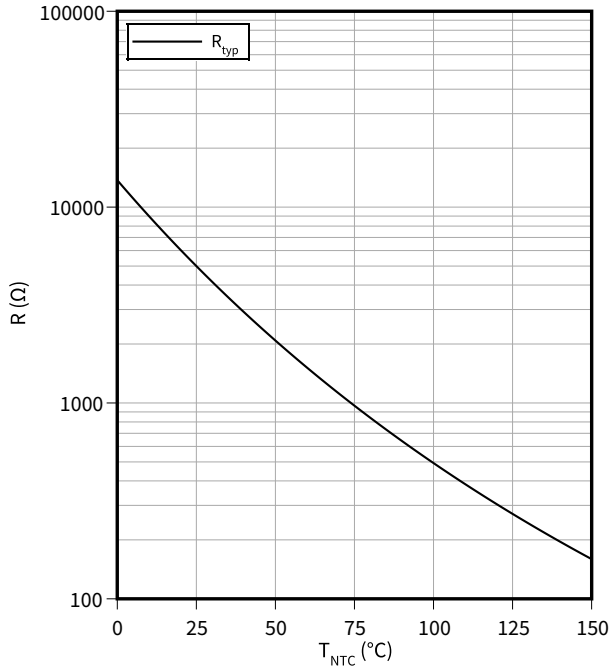
瞬态热阻抗 , MOSFET

$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



6 电路拓扑图

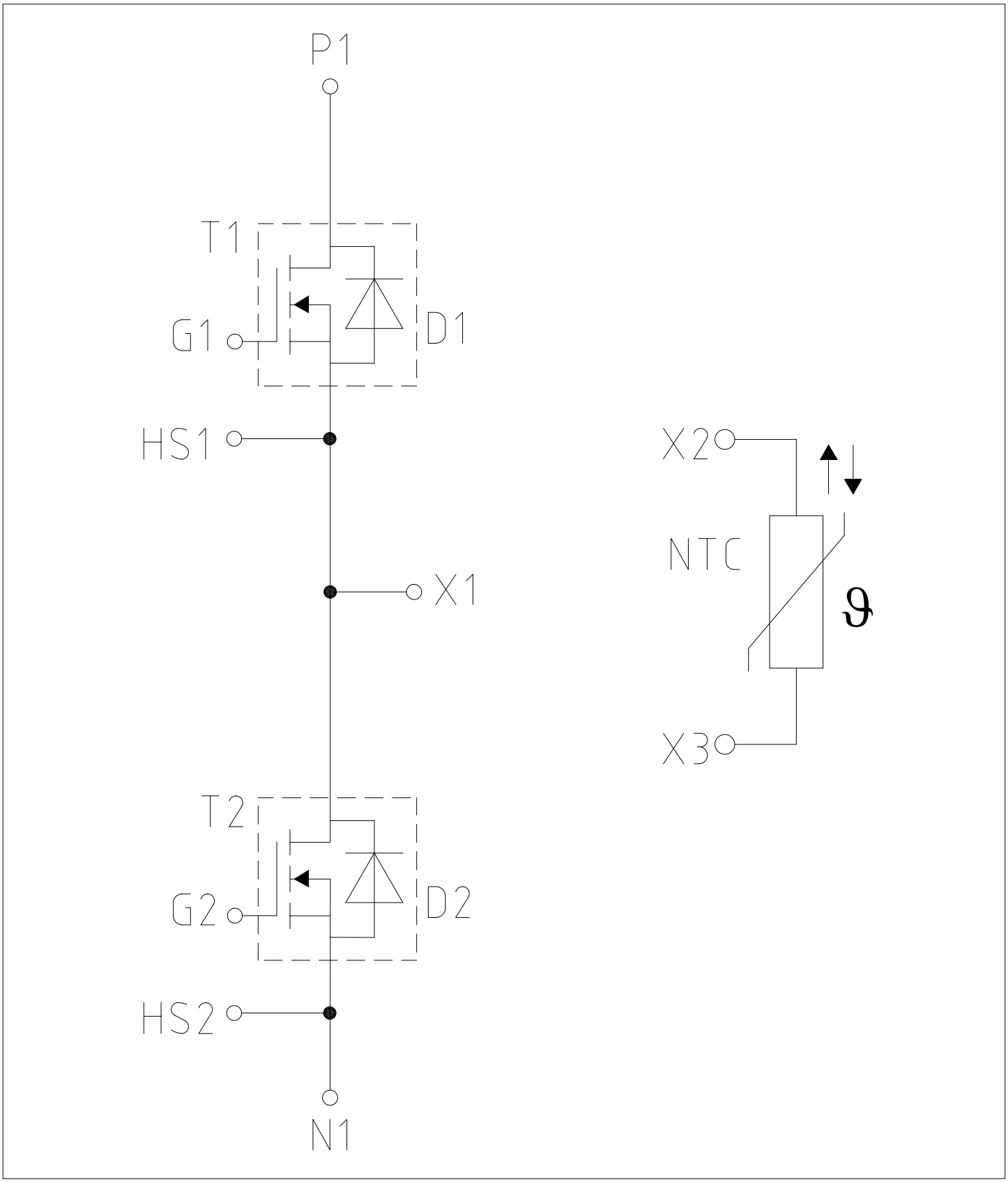


图 1

7 封装尺寸

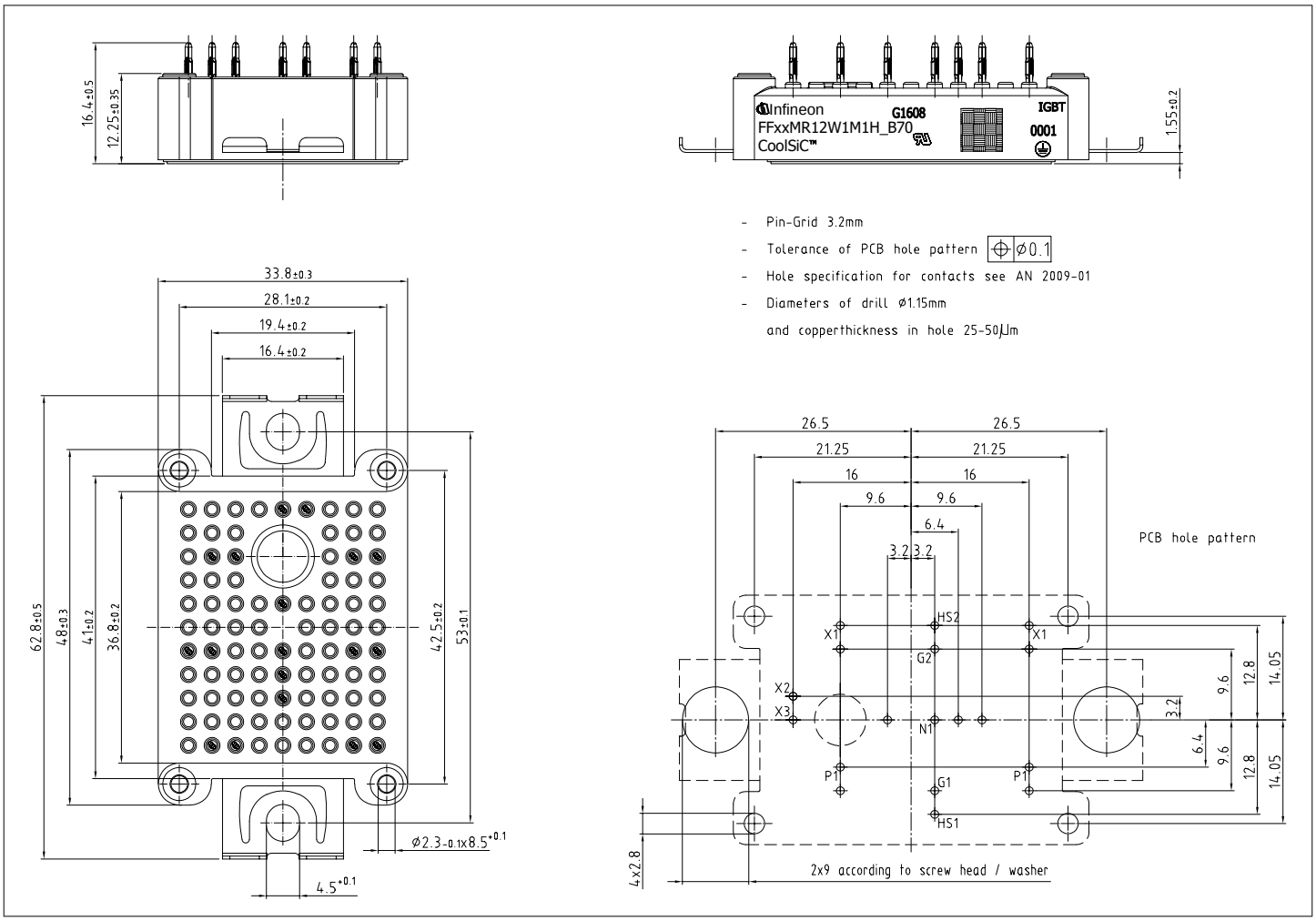

16.4±0.5
12.25±0.35
Infineon
FFxxMR12W1M1H_B70
CoolSiC™
G1608
IGBT
0001
1.55±0.2
- Pin-Grid 3.2mm
- Tolerance of PCB hole pattern ⌖ Ø0.1
- Hole specification for contacts see AN 2009-01
- Diameters of drill Ø1.15mm
and copperthickness in hole 25-50µm
33.8±0.3
28.1±0.2
19.4±0.2
16.4±0.2
62.8±0.5
48±0.3
41±0.2
36.8±0.2
42.5±0.2
53±0.1
Ø2.3-0.1x8.5+0.1
4.5+0.1
26.5
21.25
16
9.6
6.4
3.2
PCB hole pattern
X1
X2
X3
HS2
G2
N1
P1
G1
HS1
12.8
14.05
4x2.8
2x9 according to screw head / washer

图 2

8 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content*	*Digit*	*Example*
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	71549142846550549911530		71549142846550549911530

图 **3**

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2022-10-19	Initial version
0.20	2023-01-24	Preliminary datasheet
0.30	2023-02-07	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-02-07

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABE731-003

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使 用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。